



印章/Marking: Y1

特点/Features:

I_c 电流大;

用途/Applications:

用于功率放大电路, 与 SS8550 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 参数/Parameter | 符号/ Symbol | 数值/Value | 单位/Unit |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 集电极-基极电压/Collector-Base Voltage | V_{CB0} | 40 | V |
| 集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage | V_{CE0} | 25 | V |
| 发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage | V_{EB0} | 5 | V |
| 集电极连续电流/Collector Current Continuous | I_c | 1.5 | A |
| 集电极耗散功率/Collector Power Dissipation | P_c | 0.3 | W |
| 结温/Junction Temperature | T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 储存温度/Storage Temperature | T_{stg} | -55~150 | $^\circ\text{C}$ |

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|---------------|--|-----|-----|-----|---------------|
| 集电极-基极击穿电压 | $V_{BR(CB0)}$ | $I_c=100\mu\text{A}$, $I_E=0$ | 40 | | | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | $V_{BR(CE0)}$ | $I_c=100\mu\text{A}$, $I_B=0$ | 25 | | | V |
| 发射极-基极击穿电压 | $V_{BR(EB0)}$ | $I_E=100\mu\text{A}$, $I_C=0$ | 5 | | | V |
| 集电极截止电流 | I_{CB0} | $V_{CB}=40\text{V}$, $I_E=0$ | | | 0.1 | μA |
| 发射极截止电流 | I_{EB0} | $V_{EB}=5\text{V}$, $I_C=0$ | | | 0.1 | μA |
| 集电极发射极穿透电流 | I_{CE0} | $V_{CE}=20\text{V}$, $I_B=0$ | | | 0.1 | μA |
| 直流电流增益 | $h_{FE(1)}$ | $V_{CE}=1\text{V}$, $I_c=100\text{mA}$ | 120 | | 400 | |
| 直流电流增益 | $h_{FE(2)}$ | $V_{CE}=1\text{V}$, $I_c=800\text{mA}$ | 40 | | | |
| 集电极-发射极饱和压降 | $V_{CE(sat)}$ | $I_c=800\text{mA}$, $I_B=80\text{mA}$ | | | 0.5 | V |
| 基极-发射极饱和压降 | $V_{BE(sat)}$ | $I_c=800\text{mA}$, $I_B=80\text{mA}$ | | | 1.2 | V |
| 特征频率 | f_T | $V_{CE}=10\text{V}$, $I_c=50\text{mA}$, $f=30\text{MHz}$ | 100 | | | MHz |

h_{FE} 分档/Classification of $h_{FE(1)}$

| 档位/Rank | L | H | J |
|----------|---------|---------|---------|
| 范围/Range | 120~200 | 200~350 | 300~400 |

典型特性曲线图/Typical Characteristics

